

PDF issue: 2025-07-01

ヘテロポリ酸イオンの多電子移動反応メカニズム

枝, 和男 大堺, 利行

(Citation) Review of Polarography,61(2):77-86

(Issue Date) 2015

(Resource Type) journal article

(Version) Version of Record

(URL) https://hdl.handle.net/20.500.14094/90003414



ヘテロポリ酸イオンの多電子移動反応メカニズム

枝 和男*, 大堺 利行

Mechanism of Multi-Electron Transfer Reactions for Heteropolyanions

Kazuo Eda* and Toshiyuki Osakai

Received July 4, 2015

Mechanisms of multi-electron transfer reactions for heteropolyanions have been reviewed. A brief explanation has been given for the recently reported simple and synergistic electron-withdrawing effects of the O atom due to heteroatom species XO_4 , which lead to potential inversion and thus to multi-electron transfer. Perfect simulation of cyclic voltammograms has been shown for Keggin-type polyoxotungstate anions in both neutral and acidified acetonitrile.

1. はじめに

ポリ酸は、モリブデンやタングステンなど の前周期遷移金属元素の酸素酸が脱水縮合 してできた多核錯体で,強い酸性を示すため 溶液中では共役塩基として明確に決まった 構造(図1)をもつ陰イオンの形で安定に存 在する. ポリ酸イオンは, イソポリ酸とヘテ ロポリ酸イオンの2種に分類され^{*1},その組 成は,前者が $[M_m O_v]^{q-}$ (あるいは $[H_x M_m O_v]^{q-}$), 後者が $[X_x M_m O_y]^{q-}$ (x ≤ m) の一般式で表すこ とができる¹⁾. 組成式中の X はヘテロ原子, Mはアデンダ原子と呼ばれ、ポリ酸イオンを 配位化合物として見た場合,Xは中心原子, Mは配位子と見なすことができる.アデンダ 原子となる元素の種類 (*M* = Mo. W. V. Nb な ど)には限りがあるが、周期表上のほぼすべ ての族の多様な元素がヘテロ原子となり得 るため、ヘテロポリ酸イオンには同形の構造 をもつ多様な組成と電荷をもつ類縁体が存 在する^{1,2)}. また, ヘテロポリ酸イオンには, アデンダ原子と酸素がつくる酸化物骨格に よってヘテロ原子が完全に覆われた構造を

神戸大学大学院理学研究科化学専攻 (〒657-8501 兵庫県神戸市灘区六甲台 1-2-1) 持つイオン(ケギン型やドーソン型へテロポ リ酸イオンなど、図1参照)が存在し、これ らのイオンでは表面構造やイオンサイズを 変えることなく組成とイオン電荷を変化さ せることができる.しかも安定で酸化物骨格 を壊すことなく多数の電子を付加すること (還元)ができる.このため、ポリ酸(特に

^{*1} この分類には本質的な意味はないと考えら れるようになってきており,例えば,ケギン 型骨格をもつイソポリ酸 $[H_xM_{12}O_{40}]^{q-}$ (x = 2,3) とヘテロポリ酸 $[XM_{12}O_{40}]^{q-}$ (X=P, Si な ど)を一括りにすることもできるが, H原子 (厳密にはプロトン)は他のヘテロ原子と異 なり,イオンの中心に配置されると考えるに は無理があり,しかも酸解離平衡によって骨 格を壊すことなく脱着できる特異性ももつ ことから(下図参照)³,前者を議論の対象 から外した経緯もあり⁴,本稿ではこの分類 により区別した.



(a) ケギン型骨格(空間充填モデル)と
 (b) [H_xM₁₂O₄₀]^{q-}のプロトン脱着の概念図

Department of Chemistry, Graduate School of Science, Kobe University, 1-1 Rokkodai, Nadaku, Kobe 657-8501, Japan.

^{*}E-mail: eda@kobe-u.ac.jp



図 1 ヘテロポリ酸イオンの構造(多面体モデル): ケギン型 $[XM_{12}O_{40}]^{q-}$ (a),ドーソン型 $[X_2M_{18}O_{62}]^{q-}$.

ヘテロポリ酸) イオンは安定で強い酸性度や 酸化力をもち、ヘテロ原子の種類を変えるこ とにより酸性度や酸化還元電位を制御でき るため、様々な反応の触媒などとして有用で ある.実際にオレフィンの水和 (アルコール 合成) 反応のための酸触媒やメタクリル酸合 成のためのメタクロレインなどの酸化触媒 として工業的に利用されている 5. そして, 化石燃料の枯渇の問題に直面した現在にお いては持続可能なエネルギー社会を実現す る技術の開発・確立が急がれるが、そのよう な技術にはプロトン移動を伴う多電子移動 反応 (0₂+4H⁺+4e⁻ ≓ 2H₂0 および C + 4H⁺ + 4e⁻ ⇒ CH₄など)を触媒する安定 な物質の開発が重要であり、ヘテロポリ酸イ オンはそのような触媒の有望な候補である.

最近我々は, 種々のケギン型タングストヘ テロポリ酸イオン (Keggin-W-POM) $[XW_{12}O_{40}]^{r_0}^{*2}$ の電子移動反応について詳細 に調べ, ヘテロポリ酸イオンにおけるプロトン移動を伴う多電子反応 (プロトン共役多電 子移動反応)のメカニズムに関する重要な知 見を見出すことができた^{4.6)}.本稿では, そ の詳細も含め, ヘテロポリ酸イオンで起こる 多電子移動反応について紹介する.

2. ヘテロポリ酸イオンの酸化還元挙動

ヘテロポリ酸イオンのほとんどは,最高酸 化状態のアデンダ原子やヘテロ原子からな る酸化体であり,アデンダ原子が(まれにヘ テロ原子も)付加サイトとなり,多数の電子 の付加を受けて還元される.電子が1つ付加 されるとヘテロポリ酸イオンの電荷は,負に 1だけ大きくなり,それによる静電的な反発 の増加のため,さらに電子を付加する反応は

より負側の電位で起こる.このため、ヘテロ ポリ酸イオンの酸化還元反応は,通常多段の 1電子移動反応として起こる.1種類のアデ ンダ原子でできている場合、付加された電子 は、アデンダ原子間を速いホッピングにより 移動し、特に常温では、ヘテロポリ酸イオン 上で非局在化され、電荷の偏りを生まない. さらに同形の構造をもつ場合,イオンサイズ にも違いがないため、電子付加の際の静電反 発は均一で、イオン電荷に単純に比例する. その結果、ヘテロポリ酸イオンの標準酸化環 元電位はイオンの電荷にほぼ線形に依存す る.ただし、イオン電荷が同じでもヘテロ原 子の種類が異なると酸化還元電位は若干シ フトする. Pope らはこのシフトがオキソ基 の trans 位にある, 配位子の役割をするヘテ ロ原子によると考え、その効果を 'trans 効 果'と呼んだ⁷⁾.また、ポリ酸イオンの電荷 が負に大きくなると溶液中のプロトンを引 き付ける力(塩基性)が強くなり、溶液中の 水素イオン濃度によっては還元体のプロト ン付加(プロトン共役電子移動反応)が起こ り,2 電子移動反応を起こす^{8,9)}.そして, [CoMo₁₂O₄₀]⁶⁻などのように4電子移動反応を 起こすものもある¹⁰⁾.

3.1電子移動反応

3-1. XO₄の電子吸引効果⁴⁾(trans 効 果)

多電子反応を議論するためには,その素反 応である1 電子移動反応の細部を明らかに する必要がある.前述したように1電子移動 反応の標準酸化還元電位はイオン電荷にほ ぼ線形に依存するが、Pope らが呼ぶヘテロ 原子の trans 効果によりシフトする. ヘテロ 原子の特性(電気陰性度など)やヘテロポリ 酸イオンの構造などとの関係の詳細な調査 の結果、ヘテロ原子の違いによるこのシフト は図2に示したµ4-O-M 結合の距離(厳密に はこの結合の結合原子価 s) との間に特に良 い相関を示すことが明らかになった⁶. すな わち,酸無添加アセトニトリル中で測定され た各種 Keggin-W-POM の第1波の1 電子酸 化還元波の中点電位 Elle を結晶構造データ から求められた s 値 (表1) に対してプロッ

^{*2}前出の表記では, 陰イオンであることを強調す るためイオン電荷を q-としたが, 以後は基準を 正にとり z と表記し, 酸化体のそれを zo と記す.



図2 ケギン型構造とその中のµ4-O-M 結合.

トすると、それらの点は同じイオン電荷を持 つものごとに別の直線に載る(図 3). そし て、それらの直線は同じ傾きを持ち、0.510 V 間隔で並ぶ. s はu4-O-M 結合距離 d から Brown の式¹¹⁾ $s = \exp[(d_0 - d)/B] (d_0 = 1.917$ Å, B =0.370Å)により計算され, Oと M 原子の結 合に使用される結合電子の数を与える.O-M 結合の場合,その電子は M 原子から引き抜 かれると考えることができ、sはM原子上 の電子密度に関係するものと考えられる.し たがって、この値が大きくなれば、M原子上 の電子密度が小さくなり. M 原子に電子を付 加する際の静電的な反発がその分小さくな り, 還元はより正側の電位で起こることにな る. 実際に, sが大きくなれば,酸化還元電 位はより正側の値になる(図3).このこと から, Pope らが呼ぶ trans 効果は, XO₄の O 原子の電子吸引効果であると言える. ヘテロ 原子によってこの効果が変化するのは、主に ヘテロ原子のサイズによるu4-O-M 結合距離 の変化のためである.

3-2.標準酸化還元電位の定式化⁴⁾

図3によるとイオン電荷が正側に1増加す ると、アセトニトリル中での Keggin-W-POMの第1波の酸化還元電位は0.510 V 正側 にシフトする.また、図の直線の傾きから*s* が1大きくなると、電位は1.067 V 正側にシ フトすることがわかる.さらに酸無添加のア セトニトリル中で測定した各 Keggin-W-POM イオンのサイクリックボルタモグラム (CV) を各イオンの酸化体がもつ*s*による 電位のシフト分を補正した電位 E_{corr} (= E– 1.067*s*) に対してプロットすると、各イオ ンの酸化還元波は X = S の第 2 波を除き^{*3}, イオン電荷ごとに整然と並ぶ(図 4).この

表 1. Keggin-W-POM $[XW_{12}O_{40}]^{z_0}$ の s 値			
X	z_0	<i>d </i> Å	S
S	-2	2.57	0.172
Р	-3	2.45	0.237
As	-3	2.36	0.304
Si	-4	2.33	0.328
Ge	-4	2.29	0.365
В	-5	2.34	0.319
Al	-5	2.27	0.385
Ga	-5	2.23	0.429
Zn	-6	2.17	0.505
Co	-6	2.14	0.543



図 3 Keggin-W-POM の E_1^{le} 対 s プロット. Adapted with permission from ref 6. Copyright 2010 American Chemical Society.

ことは、ケギン型のヘテロポリ酸イオンがも っs値は、還元を受けても変化せず、しかも、 第2から第4波の酸化還元電位が(第3波目 の還元によるシフトが0.710Vであることを 除いて)第1波と同じイオン電荷とsへの依 存性をもつことを示す.したがって、第1か ら第4波の標準酸化還元電位は共通の式1で 表すことができる.

$$E_i^{\circ}(z_0, s) = E_i^{**} + 0.510(z_0 - i + 1) + 1.067s, \ i = 1,2,3,4 \ (1)$$

ここで E_i^{**} はイオン電荷とsが共に0の仮想

^{*&}lt;sup>3</sup> X = Sのイオンの場合,酸化体のイオン電荷が $z_0 = -2$ と小さく,他のものと同じ 0.1 M Bu₄NClO₄支持塩では溶解しにくいため,ref 6 では 0.1 M NaClO₄を使用している.このため, Na⁺とのイオン対形成が起こり,第2波の酸化 還元電位が正側にずれる.

Keggin-W-POM の第*i*波の標準酸化還元電位 を表し, $E_1^{**} = E_2^{**} = 0.577$ V, $E_3^{**} = E_4^{**} = 0.377$ Vである. この式より求めた標準酸化 還元電位を用い, 差分法に基づいてデジタル シミュレーションにより得られた各種 Keggin-W-POM の CV は実測をよく再現し, この式の正しさを証明している(図 5).

3-3. 電位式中の係数の物理的意味⁴⁾



電位式 1 で記述される酸無添加アセトニ トリル中での Keggin-W-POM の酸化還元反 応は,多段(4 段目までは確認できている) の1電子移動反応で,スキーム1のように表 せる.ここで,(n)(nは付加された電子の数 で,n = 0,1,2,3,4)はそれぞれ Keggin-W-POM の0電子(酸化体),1電子,2電子,3電子, 4 電子還元体を示し,上付きがイオン電荷, 下付きが*s*値である.式中の係数の物理的な 意味を理解するためにはこれらの反応を熱 力学的に要素分けして議論する必要がある.

まず *i* 段目の反応の標準酸化還元電位は, ポリ酸イオンへの電子付加反応のギブズエ ネルギー $\Delta G_{eg}^{\circ}(\langle i-1\rangle_{s}^{z_{0}-i+1})$ と,付加前後の ポリ酸イオンの溶媒和ギブズエネルギー $\Delta G_{solv}^{\circ}(\langle i-1\rangle^{z_{0}-i+1})$ および $\Delta G_{solv}^{\circ}(\langle i\rangle^{z_{0}-i})$ を用いて,次式のように表せる.

$$E_{i}^{\circ}(z_{0},s) = \frac{-1}{F} \left\{ \left(\Delta G_{eg}^{\circ}(\langle i-1 \rangle_{s}^{z_{0}-i+1}) + \Delta G_{solv}^{\circ}(\langle i \rangle^{z_{0}-i}) - \Delta G_{solv}^{\circ}(\langle i-1 \rangle^{z_{0}-i+1}) \right\} - E_{ref}, \ i = 1,2,3,4$$
(2)

(F: ファラデー定数, E_{ref} : 参照電極電位) ここで ΔG_{eg}° は電荷や結合原子価が 0 の仮想 Keggin-W-POM の分子軌道の準位にのみ依 存する (電子付加時の静電相互作用には関わ らない) 電子付加ギブズエネルギー項 $\Delta G_{eg}^{\circ orb}$ と静電相互作用に関わる電子付加ギブズエ ネルギーのイオン電荷依存項 $\Delta G_{eg}^{\circ g}$ および *s* 依存項 $\Delta G_{eg}^{\circ g}$ の和として次式のように表せる. $\Delta G_{eg}^{\circ}(\langle i-1\rangle_{s}^{z_{0}-i+1}) = \Delta G_{eg}^{\circ orb}(\langle i-1\rangle_{s})$ (3)



図 4 E_{corr} を電位軸として描いた Keggin-W-POM の CV 曲線. Adapted with permission from ref 4. Copyright 2015 American Chemical Society.



図 5 酸無添加のアセトニトリル中での Keggin-W-POM の CV 曲線. Adapted with permission from ref 4. Copyright 2015 American Chemical Society.

そして後者2項は、それぞれ、イオン電荷や sに線形依存するものとして扱え、係数を C_{eg}^{z} と C_{eg}^{s} として次のように表せる^{*4}

$$\Delta G_{\text{eg}}^{\circ_{Z}} \left(\left\langle i - 1 \right\rangle^{z_{0} - i + 1} \right)$$

= $-C_{\text{eg}}^{z} \cdot (z_{0} - i + 1)$ (4)
$$\Delta G_{\text{eg}}^{\circ_{S}} \left(\left\langle i - 1 \right\rangle_{s} \right) = -C_{\text{eg}}^{s} \cdot s$$
 (5)

溶媒和ギブズエネルギーについては、球形 イオンの単位表面積あたりの水和ギブズエ ネルギーがイオンの表面電場 E_{sf} の2 次関数 で表せることが最近示されたので¹²⁾、この式 を有機溶媒に拡張し、表面電場とイオン電荷 の関係 $E_{sf} = ze/4\pi\epsilon_0 r^2$ (ϵ_0 : 真空の誘電率, r: イオン半径)を用いて変換することにより、 イオン電荷の2 次関数として次式で表せる. $\Delta G_{solv}^{\circ}(n)^2 = -C_{solv}^{c2} \cdot z^2$

$$-C_{\text{solv}}^{z1} \cdot z - C_{\text{solv}}^{\text{cav}} \qquad (6)^{*!}$$

$$\Delta G_{\text{solv}}^{\circ}(\langle n \rangle^{z}) = \Delta \overline{G}_{\text{solv}}^{\circ}(\langle n \rangle) + \Delta G_{\text{solv}}^{\circ z}(\langle n \rangle^{z})$$

$$(7)^{*5}$$

$$\mathcal{L}_{\text{solv}}(\langle n \rangle) = -\mathcal{L}_{\text{solv}}^{\text{cav}} \tag{8}^{*5}$$

$$\Delta G_{\text{solv}}^{\circ z}(\langle n \rangle^{z}) = -C_{\text{solv}}^{z2} \cdot z^{2} - C_{\text{solv}}^{z1}$$

 $\Lambda \overline{G}$

ここで $\Delta G_{solv}((n)) \geq \Delta G_{solv}^{2}((n)^{2})$ は, それぞ れ,溶媒和ギブズエネルギーのイオン電荷依 存項と非依存項を表す. そして C_{solv}^{cav} はイオ ン電荷に依存しない溶媒和ギブズエネルギ 一項を与え,主に溶媒中での空洞形成に関わ る. $C_{solv}^{21} \geq C_{solv}^{20}$ はイオン電荷の1次と2次に 依存する溶媒和ギブズエネルギー項の係数 で,それぞれ主にイオン-双極子(クーロン) 相互作用とイオン-誘起双極子(分極)相互 作用に関わる.以上の式3~5,7~9を用いて 式2を書き直すと次式となる.

$$E_{i}^{\circ}(z_{0},s) = \frac{-1}{F} \{ (\Delta G_{eg}^{\circ \text{orb}}(\langle i-1 \rangle) - (C_{eg}^{z} - 2C_{solv}^{z2})(z_{0} - i) - (C_{eg}^{s} - 2C_{solv}^{s2})(z_{0} - i) - (C_{eg}^{s} \cdot s) - E_{ref},$$

$$i = 1,2,3,4$$

$$(10)$$

この式を式1と比較すると以下の式11~16 が得られる.

^{*4}陰イオンでは ΔG_{eg}° は反発項であるが, z が正 (陽イオン)のときを基準に取り,引力とし て記述している. ΔG_{eg}° は反発抑制項で実質上 引力項である.

*5 n = i - 1 or $i \subset , \quad z = z_0 - n$.

*6 1,2番目の電子は反平行スピンの関係で同じ分子軌道に入り,3番目の電子から異なる分子軌道に入ることを意味する.後者の準位は真空準位から見てE₃** - E₁**分エネルギー的に浅い.

$$\begin{split} E_{1}^{**} &= \frac{-1}{F} \left(\Delta G_{\text{eg}}^{\circ \text{orb}}(\langle 0 \rangle) - C_{\text{solv}}^{22} + C_{\text{solv}}^{21} \right) \\ &- E_{\text{ref}} = 0.577 \text{ V} \quad (11) \\ E_{2}^{**} &= \frac{-1}{F} \left(\Delta G_{\text{eg}}^{\circ \text{orb}}(\langle 1 \rangle) - C_{\text{solv}}^{22} + C_{\text{solv}}^{21} \right) \\ &- E_{\text{ref}} = 0.577 \text{ V} \quad (12) \\ E_{3}^{**} &= \frac{-1}{F} \left(\Delta G_{\text{eg}}^{\circ \text{orb}}(\langle 2 \rangle) - C_{\text{solv}}^{22} + C_{\text{solv}}^{21} \right) \\ &- E_{\text{ref}} = 0.377 \text{ V} \quad (13) \\ E_{4}^{**} &= \frac{-1}{F} \left(\Delta G_{\text{eg}}^{\circ \text{orb}}(\langle 3 \rangle) - C_{\text{solv}}^{22} + C_{\text{solv}}^{21} \right) \\ &- E_{\text{ref}} = 0.377 \text{ V} \quad (14) \\ C_{\text{eg}}^{z} - 2C_{\text{solv}}^{z2} = 0.510 F \quad (15) \\ C_{\text{eg}}^{s} = 1.067 F \quad (16) \end{split}$$

式11~14によると、イオン電荷とsが共 に0の仮想 Keggin-W-POM の第*i* 波の標準酸 化還元電位*E*^{**}(*i* = 1,2,3,4)は,共通項 $\frac{-1}{E} \left(-C_{\text{solv}}^{22} + C_{\text{solv}}^{21} \right) - E_{\text{ref}} \geq \frac{-1}{E} \Delta G_{\text{eg}}^{\circ \text{orb}}(\langle i \rangle) \mathcal{O}$ 和として与えられ,それらの値の比較は, 番目の電子が入る分子軌道のエネルギー準 位 ($\Delta G_{eg}^{orb}(\langle i \rangle)$)の相対的な位置関係を与え る. 文献¹³⁾によると, T_d 対称をもつ Keggin-W-POM の LUMO は、12 個の d_{xy} W 軌道からなる 2 重縮退した対称性適合軌道 であるとされるが、式11~14の関係と2電 子環元体が反磁性を示す既知の事実14から*6 実際の系では縮退が解けて 0.2 eV のエネル ギー差を持つ 2 つの準位に分裂しているこ とが示唆される.また, $E_2^{**} = E_1^{**}$ で,同じ 分子軌道に入る1個目と2個目の電子のエネ ルギー準位に差がないことから, on-site の電 子反発が小さいことも示唆される.このこと は、電子が入る分子軌道が 12 個の dxv W 軌 道に亘って広がっているためと考えられる. そして式 15 は酸化還元電位のイオン電荷に 対する線形係数が,電子付加時の静電的反発 ^{*4} の z 依存係数 \mathcal{C}^{z}_{eg} と溶媒和における分極 相互作用 $(z^2$ 依存) の係数 C_{solv}^{z2} の 2 倍との 差となっていることを示す. また, 式 16 か らs依存の線形係数は電子付加時の静電相互 作用の s 依存係数 Css そのものに相当するこ とがわかる. したがって, この係数はヘテロ ポリ酸の構造やアデンダ原子の種類によっ て決まる係数で,溶媒には依存しない.

式1や式11~16の関係式はアセトニトリ ル中での Keggin-W-POM の標準酸化還元電 位に対するものであるが,溶媒やアデンダ原 子の種類,さらにはヘテロポリ酸の構造型を 変えてもこれらに類似した式でそれらの標 準酸化還元電位は記述できるはずである. そ れに織り込まれないイオン対形成や特異的 溶媒和などによって起こる電位変化はこれ らの関係式からのずれとして議論できる.

4. 多電子移動反応

4-1. プロトン共役多電子移動反応

上述したようにイオン電荷が負に大きい ヘテロポリ酸イオンは、酸性溶媒中で還元さ れると還元体がプロトン付加反応を起こし、 プロトン共役多電子移動反応を示す(図4). しかし、還元に共役して起こるプロトン付加 は電子付加による電荷変化を相殺するが、そ れは電位逆転が起こることを意味するもの ではない.

多電子移動反応が起こるためには,2電子 目あるいは3電子,4電子目の電子付加が1 電子目より正側で起こる電位逆転のための 仕組みが必要である.この仕組みを明らかに する上での重要な知見は,酸添加アセトニト リル中で起こる Keggin-W-POM の多電子波 の中点電位をKeggin-W-POMのs値に対して プロットすることにより得られた(図6)^の.

そのプロットでは第1波と第2波の2電子波 の中点電位 $E_1^{p,2e} \ge E_2^{p,2e}$ のプロット点がそれ ぞれ別の直線に載る.このことは、多電子波 の酸化還元電位もsに線形依存することを示 す.そして、第1波と第2波の電位のプロッ ト点が載る直線の傾きが異なることから、酸 化還元の際に付加される電子やプロトンの



図 6 Keggin-W-POM の $E_i^{p,ne}$ 対 s プロット Adapted with permission from ref 6. Copyright 2010 American Chemical Society.

数などによってsに対する寄与が変化するこ とも示唆される. さらに, この2本の直線が 交差する領域付近に 4 電子波の中点電位 $E_1^{p,4e}$ のプロット点が認められることから, 4 電子移動反応は 2 電子移動反応をもたらす メカニズムの延長として起こることが示唆 される.

なお、図6を見る限り、多電子波の酸化環 元電位と Keggin-W-POM のイオン電荷との 間には明確な関係は見出せない. Keggin-W-POM の還元体のイオン電荷に関する情報は、 酸添加アセトニトリル中で測定した各 Keggin-W-POM イオンの CV を3-2節で行 ったと同様に Ecorr (= E - 1.067s) に対してプ ロットすることにより得られた (図 4). 図 中 Keggin-W-POM の多電子波は、いずれも、 イオン電荷-3の Keggin-W-POM が第1波の 1電子波を示す電位領域付近に現れる.この ことは、Keggin-W-POM が環元されイオン電 荷が-3 より負に大きくなると、プロトン付 加反応を起こし、-3のイオン電荷を維持す るよう振舞うことを意味する.したがって, 図6では、多電子波を示す Keggin-W-POM が 酸化体のイオン電荷 zaにかかわらず, すべて 同じイオン電荷(-3)をもち、その電荷で規 制を受けるため、見かけ上、多電子波の酸化 還元電位がイオン電荷と無関係に見えるの である.

結局,多電子波の酸化還元電位もイオン電荷に依存し,多電子移動反応をもたらす電位逆転には, XO_4 の O 原子の電子吸引効果に関わるs値とポリ酸イオンに付加される電子やプロトンが関係すると言える.

4-2. プロトン共役多電子移動反応の メカニズム⁴⁾



スキーム2

プロトン共役多電子移動反応の酸化還元 電位 E^pはその反応の素反応である複数の

$$E = {}^{e}E_{i}^{p^{\circ}}(z_{0},s) + \frac{RT}{F}\ln\frac{\left[\langle i-1\rangle_{s}^{z_{0}-i+1}\right] + \left[\mathrm{H}\langle i-1\rangle_{s}^{z_{0}-i+2}\right] + \cdots}{\left[\langle i\rangle_{s}^{z_{0}-i}\right] + \left[\mathrm{H}\langle i\rangle_{s}^{z_{0}-i+1}\right] + \left[\mathrm{H}_{2}\langle i\rangle_{s}^{z_{0}-i+2}\right] + \cdots}$$
(17)
$${}^{e}E_{i}^{p^{\circ}}(z_{0},s) = E_{i}^{\circ}(z_{0},s)$$

$$+\frac{RT}{F}\ln\frac{1+K_{i,1}(z_0,s)[\mathrm{H}^+]+K_{i,1}(z_0,s)K_{i,2}(z_0,s)[\mathrm{H}^+]^2+\cdots}{1+K_{i-1,1}(z_0,s)[\mathrm{H}^+]+K_{i-1,1}(z_0,s)K_{i-1,2}(z_0,s)[\mathrm{H}^+]^2+\cdots}$$
(18)*9

$$-RT\ln K_{n,m}(z_0,s) = \Delta G_{\rm p}^{\circ} \left({\rm H}_m \langle n \rangle_s^{z_0 - n + m} \right) + \Delta G_{\rm solv}^{\circ} \left({\rm H}_m \langle n \rangle_s^{z_0 - n + m} \right) -\Delta G_{\rm solv}^{\circ} \left({\rm H}_{m-1} \langle n \rangle_s^{z_0 - n + m - 1} \right) - \Delta G_{\rm solv}^{\circ} \left({\rm H}^+ \right)$$
(19)

(プロトン付加反応と共役する)1電子移動 反応の酸化還元電位 ^eE_i^{p°*7} (2 電子反応なら i=1,2あるいはi=3,4)によって決まる(ス キーム2). 電子移動過程が十分速い '可逆 系'での電極電位Eは、電極表面近傍のすべ ての酸化還元種の平衡濃度によって式 17の ように表せる.式中の素反応の酸化還元電位 はプロトン付加を起こしていない種の1電 子移動反応の標準酸化還元電位 E_i^{**}, 水素 イオン濃度, 関わるすべての種のプロトン付 加反応定数 K_{nm}によって表せる(式 18). こ の標準酸化還元電位は式1 により与えられ るので、一般的な CV のデジタルシミュレー ションのようにプロトン付加反応定数をパ ラメータとして式 17.18 を用いて計算され たCVを実測に合わすフィッティングを行え ば,平衡定数や拡散係数(非可逆系の場合は 速度定数も)を得ることはできる.しかし, プロトン共役多電子移動反応における電位 逆転のメカニズムを直接議論するためには, プロトン付加反応についても上で述べたの と同様の要素に分けた議論が必要である.

プロトン付加反応定数は気相でのプロト ン付加反応のギブズエネルギーと付加前後 の関連する種の溶媒和ギブズエネルギーに よって式 19 のように表せる. この時の溶媒 和ギブズエネルギーも基本的には酸無添加 の条件に関して記述されたものとほぼ同じ であるが、プロトン付加した表面と裸の表面 の溶媒和には差があるはずで、これはイオン 電荷に依存しない項を

 $\Delta \overline{G}_{solv}^{\circ}(H_m(n)) = -C_{solv}^{cav} - C_{solv}^{p} \cdot m$ (20) とすることによって織り込める(式 8 参照, *m*は付加されたプロトンの数である).他方, プロトン付加反応については,電子付加と同 じ1価の荷電粒子の付加反応と見なすこと ができ,そのギブズエネルギー ΔG_{p}° は電子付 加反応と同様に $\Delta G_{p}^{\circ} = \Delta \overline{G}_{p}^{\circ} + \Delta G_{p}^{\circ z} + \Delta G_{p}^{\circ s}$ と して表せる(式 3 参照).そして,イオン電 荷に依存する項 $\Delta G_{p}^{\circ z}$ は該当するプロトンが 付加する前のイオン電荷に対するものとし て式4と同様に次式のように表せる.

 $\Delta G_{\rm p}^{\circ_{\rm Z}} ({\rm H}_m \langle n \rangle^{{\rm Z}_0 - n + m})$

= $C_p^z \cdot (z_0 - n + m - 1)$ (21) 一方,イオン電荷や s に依存しない項 $\Delta \overline{G}_p^c$ は 溶媒和のようにプロトンが付加することを 考え,プロトン付加した表面と裸の表面での 差を織り込み,m - 1 個のプロトンが既に付 加したものに対するプロトン付加として式 19 と同様に以下のように表せる.

 $\Delta \bar{G}_{p}^{\circ}(H_{m}(n)) = -\bar{C}_{p}^{bs} - C_{p}^{p} \cdot (m-1)$ (22) そして, s 依存項 $\Delta G_{p}^{\circ s}$ は, 図 6 の 2 本の直線 の傾きに関わる項で, 4 - 1 節で述べたよう にポリ酸イオンに付加される電子やプロト ンの数に関係るものである. それらを表現す る様々な式の検討により,次式が実際の CV を再現するのに最適な結果を与えることが 明らかになった.

 $\Delta G_{p}^{\circ s}(H_{m}\langle n \rangle_{s}) = -C_{p}^{s} \cdot m \cdot s \cdot n$ (23) 式 9^{*10}, 20~23 を式 19 に代入して K_{nm} を求 め, デジタルシミュレーションを行ったが, 多くの未知の係数が含まれるため, その数を

 ^{*&}lt;sup>7</sup> *e* E_i^{p°}の左肩の*e*は素反応(elementary reaction)の酸化還元電位であることを示す.
 *⁸厳密には式量電位であるが,活量係数が1とおける希薄な濃度の場合,このようにおいても差し支えない.本稿で示した CVの測定時の Keggin-W-POM 濃度は0.5 mM である.

^{*9} Ref 4 での対応する式の右辺第 2 項の分母, 分子には,それぞれ, $K_{i,2}(z_0,s) \ge K_{i-1,2}(z_0,s)$ が抜けている. ^{*10} $\Delta G_{sol}^{\circ z}(H_m \langle n \rangle^2) \Rightarrow \Delta G_{sol}^{\circ z}(\langle n \rangle^2).$

最小にするため、4-1節や4-2節で明らか になった関係(式11~16)や、プロトン共 役電子移動におけるトータルのギブズエネ ルギー変化が経路(プロトン付加が電子移動 に先行するか後行するか)によらないことに 基づく次式を用いた.

 C_p^z = C_{eg}
 (24)*¹¹

 これらの関係式を用いると、プロトン付加反応定数の比を含む三つの項を以下のように表すことができる。

$$RTln\frac{K_{0,1}(z_0+1,s)}{K_{0,1}(z_0,s)} = 0.510F$$
(25)

$$RTln \frac{K_{n+1,m}(z_0, s)}{K_{n,m}(z_0, s)} = 0.510F + C_p^s \cdot m \cdot s \quad (26)$$
$$RTln \frac{K_{l,m+1}(z_0, s)}{K_{n,m}(z_0, s)} = C_p^p + C_p^s \cdot s \cdot n -0.510F \quad (27)$$

これらの三つの式を用い, 基点となる $K_{0,1}(z_0,s)$ を一つ決めると, 他のプロトン付 加反応定数は C_p^p と C_p^s をパラメータとして一 義的にすべて決めることができる.

詳細は割愛するが、このようにして求めら れたプロトン付加反応定数を用い、式 17、 18 に基づいて各種の CV をデジタルシミュ レーションすると、実測をよく再現すること ができた(図7)*12. この良い再現は,式23 で表されるプロトン付加反応のギブズエネ ルギーのs依存項 $-C_n^s \cdot m \cdot s \cdot n$ が, ヘテロポ リ酸イオンにおけるプロトン共役電子移動 反応での電位逆転に関わる効果を正しく表 すことを示している、この項の形から、その 効果は M 原子に結合した表面 O 原子に付加 したプロトンと XO4 の O 原子が相乗的に関 わり M 原子上の電子を引き抜き,電子付加 の際の静電反発を抑え,電子移動反応が起こ る電位を正側ヘシフトさせる効果(相乗的電 子吸引効果)と考えることができる.

4-3. 擬ヤーン・テラー歪みと多電子 移動

アデンダ原子の中にはモリブデンのよう にそれがつくるポリ酸イオンの酸化物骨格 の架橋酸素結合距離に擬ヤーン・テラー効果



図 7 酸無添加アセトニトリル中での Keggin-W-POM の CV 曲線. Adapted with permission from ref 4. Copyright 2015 American Chemical Society.

*¹³ によって長短の非対称な歪みを示すもの がある(図 8).この歪みは還元により開放 されるとされ,開放のために余分なエネルギ

- *¹¹ C_p^z と C_{eg}^z は, それぞれ, (正, 負は異なるが) 1 価の荷電粒子である陽子と電子を電荷 z のイオンに付加する反応の静電相互作用に だけに関わるギブズエネルギーの z に対す る係数であり, 符号が同じになるようにと ってあるため (式4 と 21 参照), この式が 成立するのは理に適っている.また, プロ トン共役電子移動反応で電荷相殺効果が成 立するのはこの式による.
- *12 可逆系では素反応の標準酸化還元電位とすべてのプロトン付加反応定数がわかれば、 CV 曲線をシミュレートすることができる. Ref 4 では、反応中に起こる現象の熱力学的な記述に基づいてこれらの電位や反応定数を直接求める方法によって CV 曲線の完璧なシミュレーションを初めて実現している.それは、用いられた Keggin-W-POM/アセトニトリル系が余計な反応や大きな構造変化の起こらない理想的な系であるためである.
- *13 ヤーン・テラー効果と同様の分子の対称性 低下効果で,振動に伴う原子核の変位によ る電子エネルギー変化 '振電相互作用'の うちの原子核の変位に対する 2 次の摂動エ ネルギーに関わる分子軌道間の相互作用に よる分子変形効果¹⁵.



8 における C_{solv}^{z2} の値が大きい?)水のような 溶媒中では、プロトン共役電子移動を起こさ なくとも、第2波の電位逆転が起こり、2 電子移動反応を示す場合がある(例えば $[P_{2}Mo_{18}O_{62}]^{6}$)¹⁶.

この歪みの効果は Yan らの $M_n O_m$ 環構造モ デルに対する量子化学計算によって説明さ れており、環サイズが大きいほど、またヘテ ロ原子のつくる XO₄ の電荷が負に大きい程 大きくなるとされる¹⁷⁾.実際、より大きな環 をもつ[$(P_2O_7)_2Mo_{30}O_{90}$]⁶は[$P_2Mo_{18}O_{62}$]⁶が 2 電子移動反応を示さない(水よりアクセプタ 数の小さい)アセトニトリル中でも2電子移 動反応を示し(図9a)、この効果による2電 子移動反応であると示唆される^{18)*14}.ただし、 上述するようにこの効果による多電子移動 反応にはアデンダ原子特異性があり、 [$(P_2O_7)_2Mo_{30}O_{90}$]⁸と同型の[$(P_2O_7)_2Mo_{30}O_{90}$]⁸と同型の[$(P_2O_7)_2Mo_{30}O_{90}$]⁸は,

多段の1電子移動反応を示し、2電子移動反



図 9 $[(P_2O_7)_2M_{30}O_{90}]^8$ のアセトニトリル溶液 (0.25 mM,酸無添加)のCV曲線: M=Mo (a) Adapted from ref 18, Copyright 2009, with permission from Elsevier; M=W (b) Adapted from ref 19, Copyright 2012, with permission from Elsevier.

応は示さない(図 9b)¹⁹⁾.

4-4. 第3の多電子移動メカニズム の可能性

本稿で紹介した議論に基づくと,これま で述べたヘテロポリ酸イオンで起こる 2 種 類の多電子移動反応以外のメカニズムでも 多電子移動を発現する可能性が考えられる. そのメカニズムによる多電子移動反応は実

*14 実際には、ヘテロポリ酸イオンの架橋酸素結 合距離の歪みの程度とこのメカニズムによる 多電子移動の発現の間に明確な関係が認めら れない例も散見される.ただ、この効果によ る MoO₆ 八面体などの歪み(WO₆ 八面体は, その中心位置に W 原子を配置し、2 重結合的 な短いW-O結合を1本だけもつモノオキソ構 造をとり、この結合軸に対して対称なのに対 し、MoO₆八面体は中心からずれた位置に Mo 原子を配置し,2本の2重結合的な Mo-O 結 合をもつ ジオキソ構造を取り、2 重結合軸に 対して非対称となる)は良く知られており²⁰⁾, 最近見出された ジオキソ構造のアンダーソン 型ヘテロポリ酸イオンから モノオキソ構造の ケギン型ヘテロポリ酸イオンへの直接の転換 反応(下図)²¹⁾に対しても、タングストヘテロ ポリ酸イオンがケギン型(モノオキソ構造)を 好むのに対し、モリブドヘテロポリ酸イオンは アンダーソン型(ジオキソ構造)を好む傾向が あり, 擬ヤーン・テラー効果由来の特異性をも つことは明らかである.したがって、擬ヤー ン・テラー効果による多電子移動の発現につい ての疑いはないが、実際に見出されるヘテロポ リ酸イオンの歪みに及ぼす擬ヤーン・テラー効 果の寄与の割合を正確に見積もった上で多電 子移動反応の発現との関係を再評価する必要 はあると考える.



アンダーソン型からケギン型 への転換

際には確認されていないが,最後に,その可 能性について述べる.

式1の右辺第1項の係数は一般的には正で, 電子付加(式1中のiの増加)に対する静電 的な反発の増加の程度を表すものであると いうイメージが強い.しかし,この係数は前 述したように $C_{eg}^{Z}-2C_{solv}^{Z2}$ で与えられ(式8), 条件によっては負の値にもなり得る.そして, その値がi+1番目とi番目の電子の入る分子 軌道の準位の差($E_{i+1}^{**} - E_i^{**}$)より大きな負 の値である場合には(式1参照),i+1番目 の電子付加はi番目の電子付加より正側の電 位で起こり(電位逆転),多電子移動反応が 起こるはずである.

実際にそのようなことを起こさせるには、 C_{solv}^{22} の大きいな溶媒や C_{eg}^{z} の小さいヘテロ ポリ酸イオンを使用すればよい.そして、後 者の C_{eg}^{z} に関して述べると、 C_{eg}^{z} は電荷 zの イオンへの電子付加反応の静電的相互作用 だけに関わるギブズエネルギー $\Delta G_{eg}^{\circ z}$ のzに 対する係数であり、 $C_{eg}^{z} \propto 1/r$ の関係をもつ

(球形の半径rのイオンでは、単純には $\Delta G_{eg}^{\circ 2}((n)^{z}) \doteq -N_{A}ze^{2}/4\pi\epsilon_{0}r$ と表すことが できる²²⁾.ただし、 N_{A} はアボガドロ数、eは 電子素量).このことからイオン半径の大き なヘテロポリ酸イオンを設計すれば、プロト ン共役電子移動や擬ヤーン・テラー効果がな くても多電子移動反応を起こす可能性があ る.

5. 参考文献

- 1) M. T. Pope, *Heteropoly and Isopoly Oxometalates*; Springer-Verlag: Berlin (1983).
- T. Okuhara, N. Mizuno, M. Misono, *Adv. Catal.*, 41, 113 (1996).

- S. Himeno, K. Nakajima, K. Eda, *Polyhedron*, 29, 2595 (2010).
- 4) K. Eda, T. Osakai, *Inorg. Chem.*, **54**, 2793 (2015).
- 奥原敏夫, 御園生誠, 有機合成化学協会誌, 51, 128 (1993).
- K. Nakajima, K. Eda, S. Himeno, *Inorg. Chem.*, 49, 5212 (2010).
- J. J. Altenau, M. T. Pope, R. A. Prados, H. So, *Inorg. Chem.*, 14, 417 (1975).
- J. N. Barrows, M. T. Pope, Adv. Chem. Ser., 226, 403 (1990).
- K. Maeda, S. Himeno, T. Osakai, A. Saito, T. Hori, J. Electroanal. Chem., 364, 149 (1994).
- 10) G.-G. Gao, L. Xu, W.-J. Wang, X.-S. Qu, H. H. Liu, Y.-Y. Yang, *Inorg. Chem.*, 47, 2325 (2008).
- I. D. Brown, D. Altermatt, Acta Crystallogr., B41, 244 (1985).
- 12) W. Murakami, K. Eda, M. Yamamoto, T. Osakai, *Bull. Chem. Soc. Jpn.*, 87, 403 (2014).
- 13) J. M. Maestre, X. Lopez, C. Bo, J.-M. Poblet, N. Casañ-Pastor, J. Am. Chem. Soc., **123**, 3749 (2001).
- 14) N. Casañ-Pastor; L. C. W. Baker, J. Am. Chem. Soc., 114, 10384 (1992).
- I. B. Bersuker, *The Jahn-Teller Effect*, Cambridge University Press, Cambridge (2006), Chap. 4.
- 16) J. F. Garvey, M. T. Pope, *Inorg. Chem.*, 17, 1115 (1978).
- L. Yan, X. Lopez, J. J. Carbo, R. Sniatynsky, D. C. Duncan, J. M. Poblet, *J. Am. Chem. Soc.*, **130**, 8223 (2008).
- 18) K. Eda, S. Maeda, S. Himeno, T. Hori, *Polyhedron*, 28, 4032 (2009).
- 19) K. Eda, K. Den, S. Himeno, *Inorg. Chim. Acta*, 382, 182 (2012).
- 20) F. Corà, A. Patel, N. M. Harrison, C. Poetti, C. R. A. Catlow, J. Mater. Chem., 7, 959 (1997).
- 21) S. Himeno, S. Murata, K. Eda, *Dalton Trans.*, 6114 (2009).
- 22) K. Maeda, H. Katano, T. Osakai, S. Himeno, A. Saito, *J. Electroanal. Chem.*, **389**, 167 (1995).